

## 概述

PT8261内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护 IC。

PT8261适合于对 1 节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。

## 特点

如下特点:

### (1) 高精度电压检测电路

● 过充电检测电压	4.280V	精度±25mV
● 过充电释放电压	4.080V	精度±50mV
● 过放电检测电压	3.000V	精度±50mV
● 过放电释放电压	3.000V	精度±50mV
● 放电过流检测电压	80mV	精度±15mV
● 充电过流检测电压	-100mV	精度±20mV
● 负载短路检测电压	0.58V	精度±100mV

### (2) 各延迟时间由内部电路设置 (不需外接电容)

### (3) 休眠功能

### (4) 低耗电流

- 工作模式 典型值3.0μA, 最大值6.0μA (VDD=3.9V)
- 休眠模式 最大值0.1μA (VDD=2.0V)

### (5) 连接充电器的端子用高耐压设计 (CS 端子和 OC 端子, 绝对最大额定值是 25V)

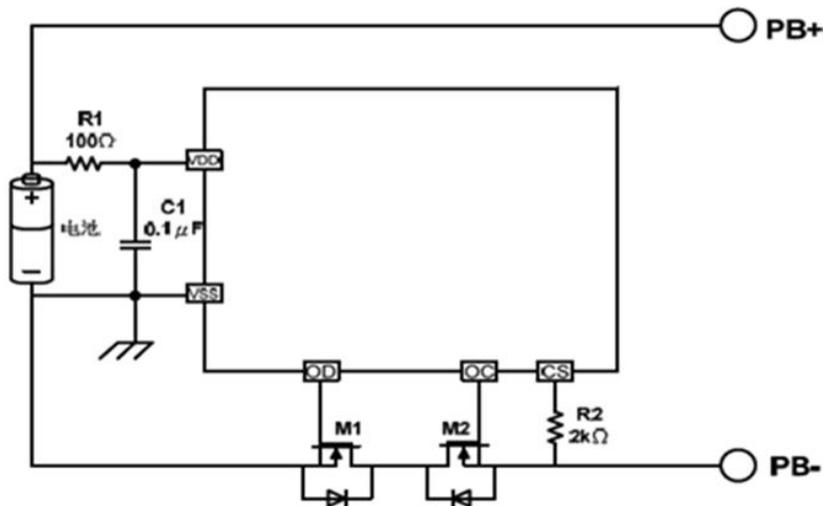
### (6) 允许向 0V 电池充电功能

### (7) 宽工作温度范围: -40°C~+85°C

### (8) 小型封装: SOT-23-6L

### (9) 无卤素绿色环保产品

典型应用



产品目录

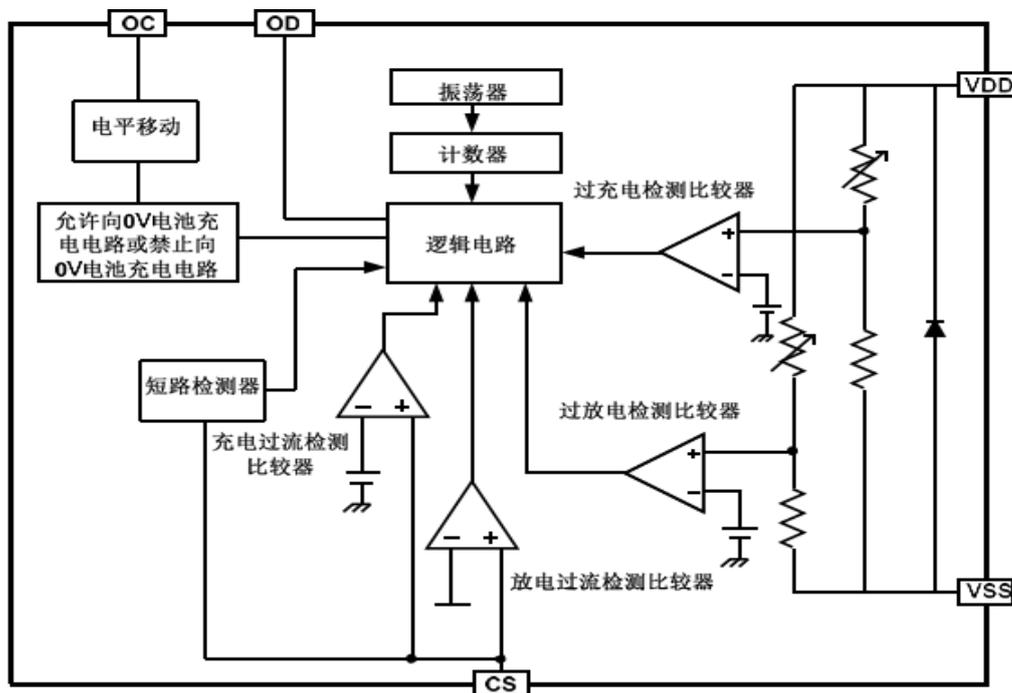
表 1、系列产品电气参数选择表

型号	过充电检测电压	过充电释放电压	过放电检测电压	过放电释放电压	放电过流检测电压	充电过流检测电压	向 0V 电池充电功能	休眠功能 / 过放自恢复功能
	V <sub>CU</sub>	V <sub>CR</sub>	V <sub>DL</sub>	V <sub>DR</sub>	V <sub>DIP</sub>	V <sub>CIP</sub>	允许/禁止	
PT8261	4.280V	4.080V	3.000V	3.000V	80mV	-100mV	允许	休眠功能

应用

1 节锂离子可再充电电池组 / 1 节锂聚合物可再充电电池组

方框图



## 脚位信息

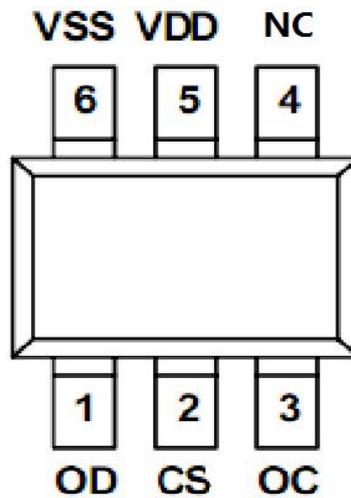


表 2、SOT-23-6L封装

脚位	符号	说明
1	OD	放电控制用 MOSFET 门极连接端子
2	CS	过电流检测输入端子，充电器检测端子
3	OC	充电控制用 MOSFET 门极连接端子
4	NC	无连接
5	VDD	电源端，正电源输入端子
6	VSS	接地端，负电源输入端子

## 绝对最大额定值

表 3、绝对最大额定值（VSS=0V，Ta=25℃，除非特别说明。）

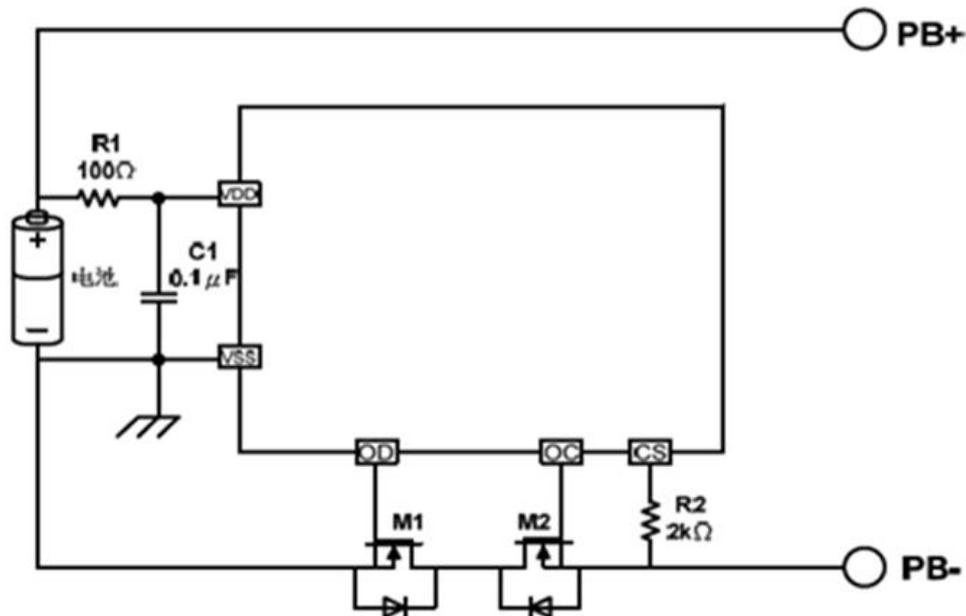
项目	符号	规格	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	$V_{DD}$	VSS-0.3~VSS+10	V
OC 输出端子电压	$V_{OC}$	VDD-25~VDD+0.3	V
OD 输出端子电压	$V_{OD}$	VSS-0.3~VDD+0.3	V
CS 输入端子电压	$V_{CS}$	VDD-25~VDD+0.3	V
工作温度范围	$T_{OP}$	-40~+85	℃
储存温度范围	$T_{ST}$	-40~+125	℃
容许功耗	$P_D$	250	mW

## 电气特性

表 4、电气参数 (VSS=0V, Ta=25°C, 除非特别说明。)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>输入电压</b>						
VDD-VSS 工作电压	V <sub>DSOP1</sub>	-	1.5	-	8	V
VDD-CS 工作电压	V <sub>DSOP2</sub>	-	1.5	-	25	V
<b>耗电流</b>						
工作电流	I <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub> =3.9V	-	3.0	6.0	μA
休眠电流	I <sub>OD</sub>	V <sub>DD</sub> =2.0V	-	-	0.1	μA
<b>检测电压</b>						
过充电检测电压	V <sub>CU</sub>		4.255	4.280	4.305	V
过充电释放电压	V <sub>CR</sub>		4.030	4.080	4.130	V
过放电检测电压	V <sub>DL</sub>		2.950	3.000	3.050	V
过放电释放电压	V <sub>DR</sub>		2.950	3.000	3.050	V
放电过流检测电压	V <sub>DIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V	65	80	95	mV
负载短路检测电压	V <sub>SIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.9V	0.480	0.580	0.680	V
充电过流检测电压	V <sub>CIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V	-120	-100	-80	mV
<b>延迟时间参数</b>						
过充电检测延迟时间	T <sub>OC</sub>	V <sub>DD</sub> =3.9V→4.5V	1000	1300	1600	ms
过放电检测延迟时间	T <sub>OD</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V→2.0V	115	145	175	ms
放电过流检测延迟时间	T <sub>DIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V,CS=0.4V	6.75	9	11.25	ms
充电过流检测延迟时间	T <sub>CIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V,CS=-0.2V	6	8	10	ms
负载短路检测延迟时间	T <sub>SIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.0V,CS=1.3V	200	300	400	μs
<b>控制端子输出电压</b>						
OD 端子输出高电压	V <sub>DH</sub>		VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OD 端子输出低电压	V <sub>DL</sub>		-	0.1	0.5	V
OC 端子输出高电压	V <sub>CH</sub>		VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OC 端子输出低电压	V <sub>CL</sub>		-	0.1	0.5	V
<b>向 0V 电池充电的功能</b>						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V <sub>0CH</sub>	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V

## 应用电路



标记	器件名称	用途	最小值	典型值	最大值	说明
R1	电阻	限流、稳定 VDD、加强 ESD	100Ω	100Ω	200Ω	*1
R2	电阻	限流	1kΩ	2kΩ	2kΩ	*2
C1	电容	滤波，稳定 VDD	0.01μF	0.1μF	1.0μF	*3
M1	N-MOSFET	放电控制	-	-	-	*4
M2	N-MOSFET	充电控制	-	-	-	*5

\*1、R1 连接过大电阻，由于耗电流会在 R1 上产生压降，影响检测电压精度。当充电器反接时，电流从充电器流向 IC，若 R1 过大有可能导致 VDD-VSS 端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。

\*2、R2 连接过大电阻，当连接高电压充电器时，有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流，请尽可能选取较大的阻值。

\*3、C1 有稳定 VDD 电压的作用，请不要连接 0.01μF 以下的电容。

\*4、使用 MOSFET 的阈值电压在过放电检测电压以上时，可能导致在过放电保护之前停止放电。

\*5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时，N-MOSFET 有可能被损坏。

## 注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改，请及时与业务部联系获取最新版规格。
2. 外围器件如需调整，建议客户进行充分的评估和测试。

## 工作说明

### 正常工作状态

此 IC 持续侦测连接在 VDD 和 VSS 之间的电池电压，以及 CS 与 VSS 之间的电压差，来控制充电和放电。当电池电压在过放电检测电压 (VDL) 以上并在过充电检测电压 (VCU) 以下，且 CS 端子电压在充电过流检测电压 (VCIP) 以上并在放电过流检测电压 (VDIP) 以下时，IC 的 OC 和 OD 端子都输出高电平，使充电控制用 MOSFET 和放电控制用 MOSFET 同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，充电和放电都可以自由进行。

**注意：**初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接 CS 端子和 VSS 端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

### 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，一旦电池电压超过过充电检测电压 (VCU)，并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间 (TOC) 以上时，PT8261 系列 IC 会关闭充电控制用的 MOSFET (OC 端子)，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。过充电状态在如下 2 种情况下可以释放：

不连接充电器时：

(1) 由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压 (VCR) 以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

(2) 连接负载放电，放电电流先通过充电控制用 MOSFET 的寄生二极管流过，此时 CS 端子侦测到一个“二极管正向导通压降 (Vf)”的电压。当 CS 端子电压在放电过流检测电压 (VDIP) 以上且电池电压降低到过充电检测电压 (VCU) 以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

**注意：**进入过充电状态的电池，如果仍然连接着充电器，即使电池电压低于过充电释放电压 (VCR)，过充电状态也不能释放。断开充电器，CS 端子电压上升到充电过流检测电压 (VCIP) 以上时，过充电状态才能释放。

### 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，当电池电压降低到过放电检测电压 (VDL) 以下，并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间 (TOD) 以上时，PT8261 系列 IC 会关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子)，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

当关闭放电控制用 MOSFET 后，CS 由 IC 内部电阻上拉到 VDD，使 IC 耗电流减小

到休眠时的耗电流值，这个状态称为“休眠状态”。

过放电状态的释放，有以下两种情况：

(1) 连接充电器，若 CS 端子电压低于充电过流检测电压 ( $V_{CIP}$ )，当电池电压高于过放电检测电压 ( $V_{DL}$ ) 时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

(2) 连接充电器，若 CS 端子电压高于充电过流检测电压 ( $V_{CIP}$ )，当电池电压高于过放电释放电压 ( $V_{DR}$ ) 时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

### 放电过流状态（放电过流检测功能和负载短路检测功能）

正常工作状态下的电池，PT8261系列 IC 通过检测 CS 端子电压持续侦测放电电流。一旦 CS 端子电压超过放电过流检测电压 ( $V_{DIP}$ )，并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间 ( $T_{DIP}$ )，则关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子)，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。

而一旦 CS 端子电压超过负载短路检测电压 ( $V_{SIP}$ )，并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间 ( $T_{SIP}$ )，则也关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子)，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

当连接在电池正极 (PB+) 和电池负极 (PB-) 之间的阻抗大于放电过流/负载短路释放阻抗 (典型值约  $300k\Omega$ ) 时，放电过流状态和负载短路状态释放，恢复到正常工作状态。另外，即使连接在电池正极 (PB+) 和电池负极 (PB-) 之间的阻抗小于放电过流/负载短路释放阻抗，当连接上充电器，CS 端子电压降低到放电过流保护电压 ( $V_{DIP}$ ) 以下，也会释放放电过流状态或负载短路状态，回到正常工作状态。

#### 注意：

若不慎将充电器反接时，回路中的电流方向与放电时电流方向一致，如果 CS 端子电压高于放电过流检测电压 ( $V_{DIP}$ )，则可以进入放电过流保护状态，切断回路中的电流，起到保护的作用。

### 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果 CS 端子电压低于充电过流检测电压 ( $V_{CIP}$ )，并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延迟时间 ( $T_{CIP}$ )，则关闭充电控制用的 MOSFET (OC 端子)，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

进入充电过流检测状态后，如果断开充电器使 CS 端子电压高于充电过流检测电压 ( $V_{CIP}$ ) 时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

### 向 0V 电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当连接在电池正极（PB+）和电池负极（PB-）之间的充电器电压，高于“向 0V 电池充电的充电器起始电压（ $V_{0CH}$ ）”时，充电控制用 MOSFET 的门极固定为 VDD 端子的电位，由于充电器电压使 MOSFET 的门极和源极之间的电压差高于其导通电压，充电控制用 MOSFET 导通（OC 端子），开始充电。这时，放电控制用 MOSFET 仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测电压（ $V_{DL}$ ）时，PT8261 系列 IC 进入正常工作状态。

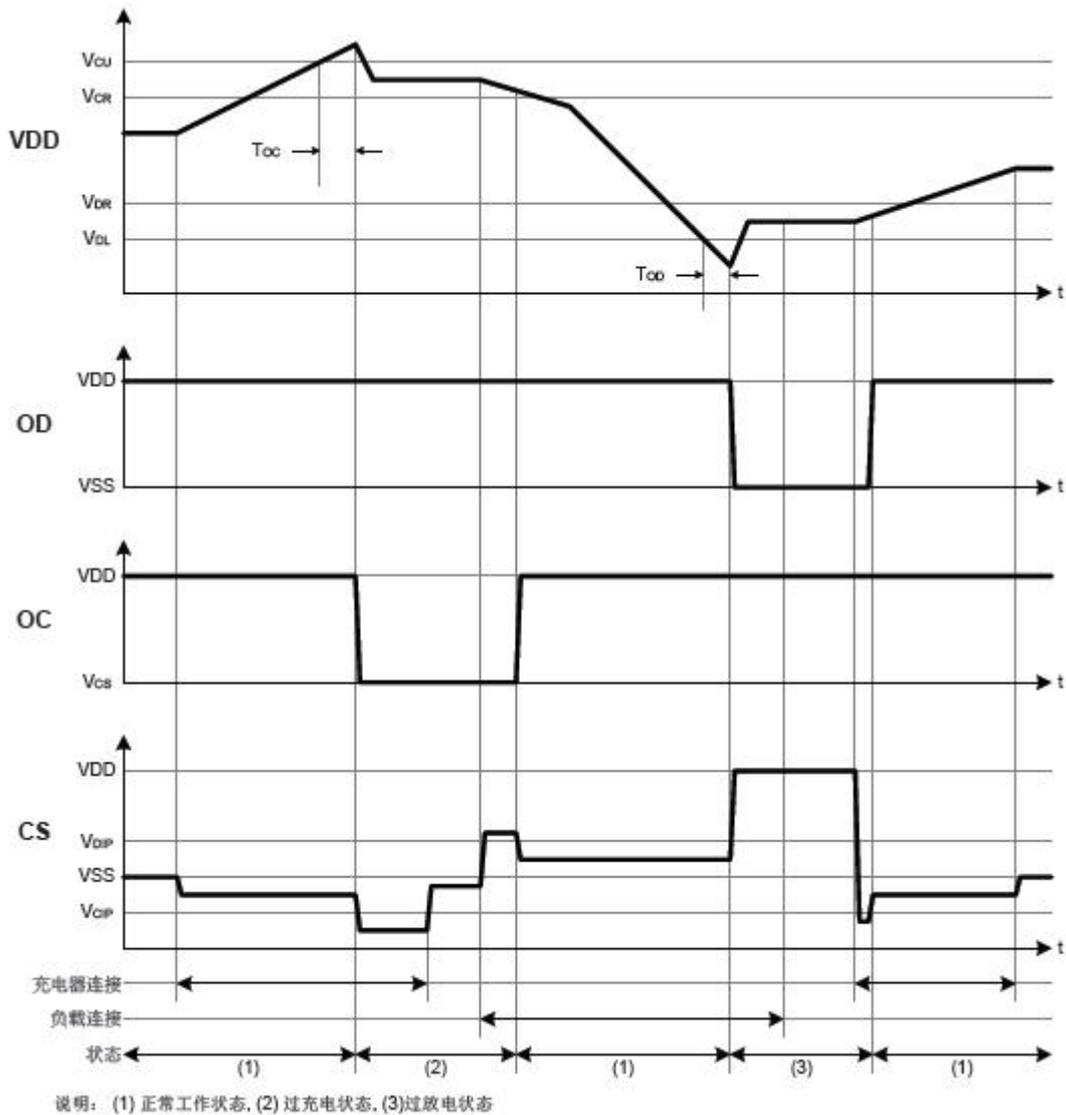
### 注意：

（1）某些完全自放电后的电池，不允许被再次充电，这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向 0V 电池充电”的功能，还是“禁止向 0V 电池充电”的功能。

（2）“允许向 0V 电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此，使用“允许向 0V 电池充电”功能的 IC，在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压（ $V_{DL}$ ）以下时，不能进行充电过流状态的检测。

## 时序图

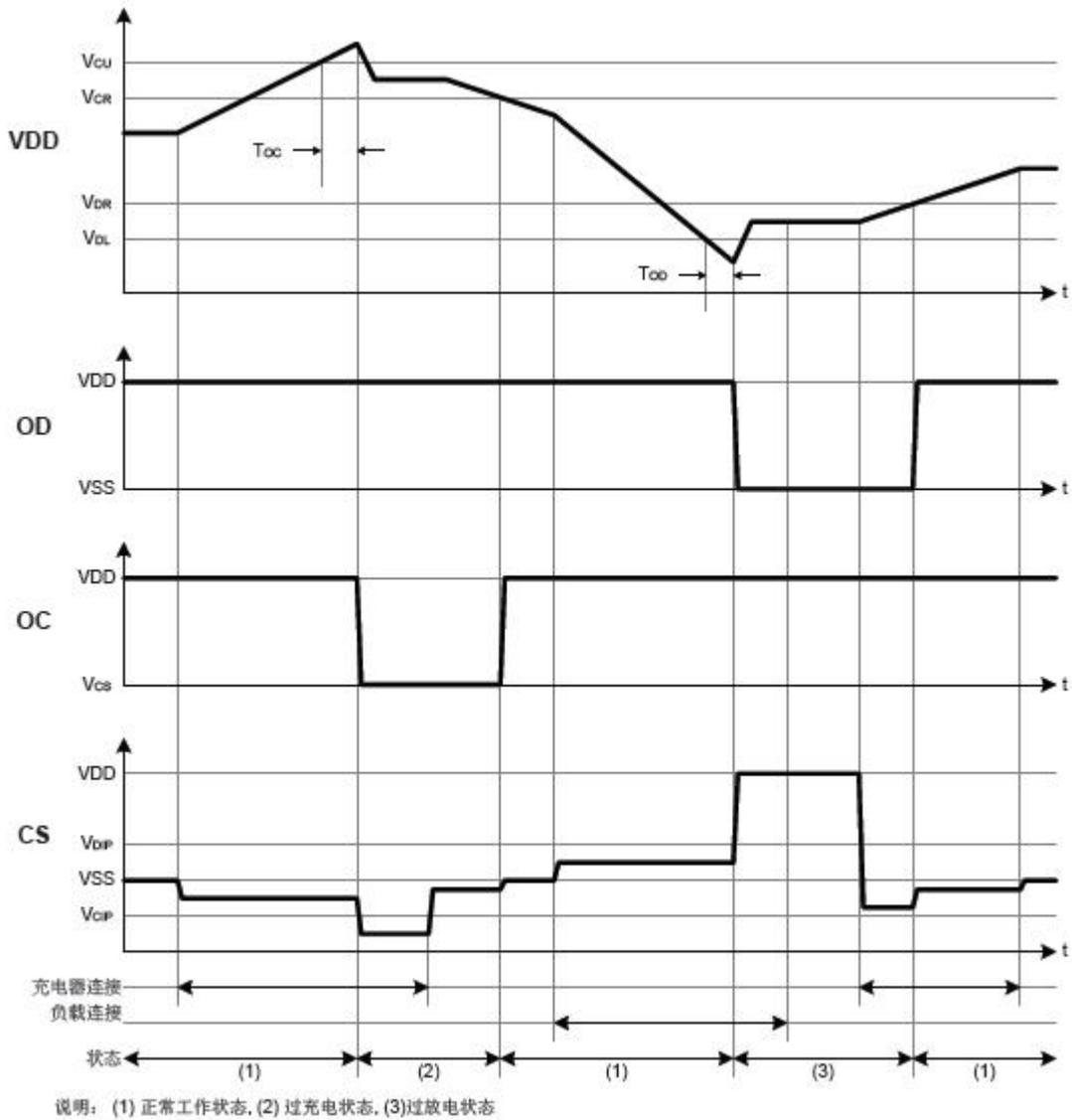
## (1) 过充电检测，过放电检测



## 说明:

- (a) 过充释放条件:  $V_{CS} > V_{DIP}$  &  $V_{DD} < V_{CU}$ 。
- (b) 过放释放条件:  $V_{CS} < V_{CIP}$  &  $V_{DD} > V_{DL}$ 。

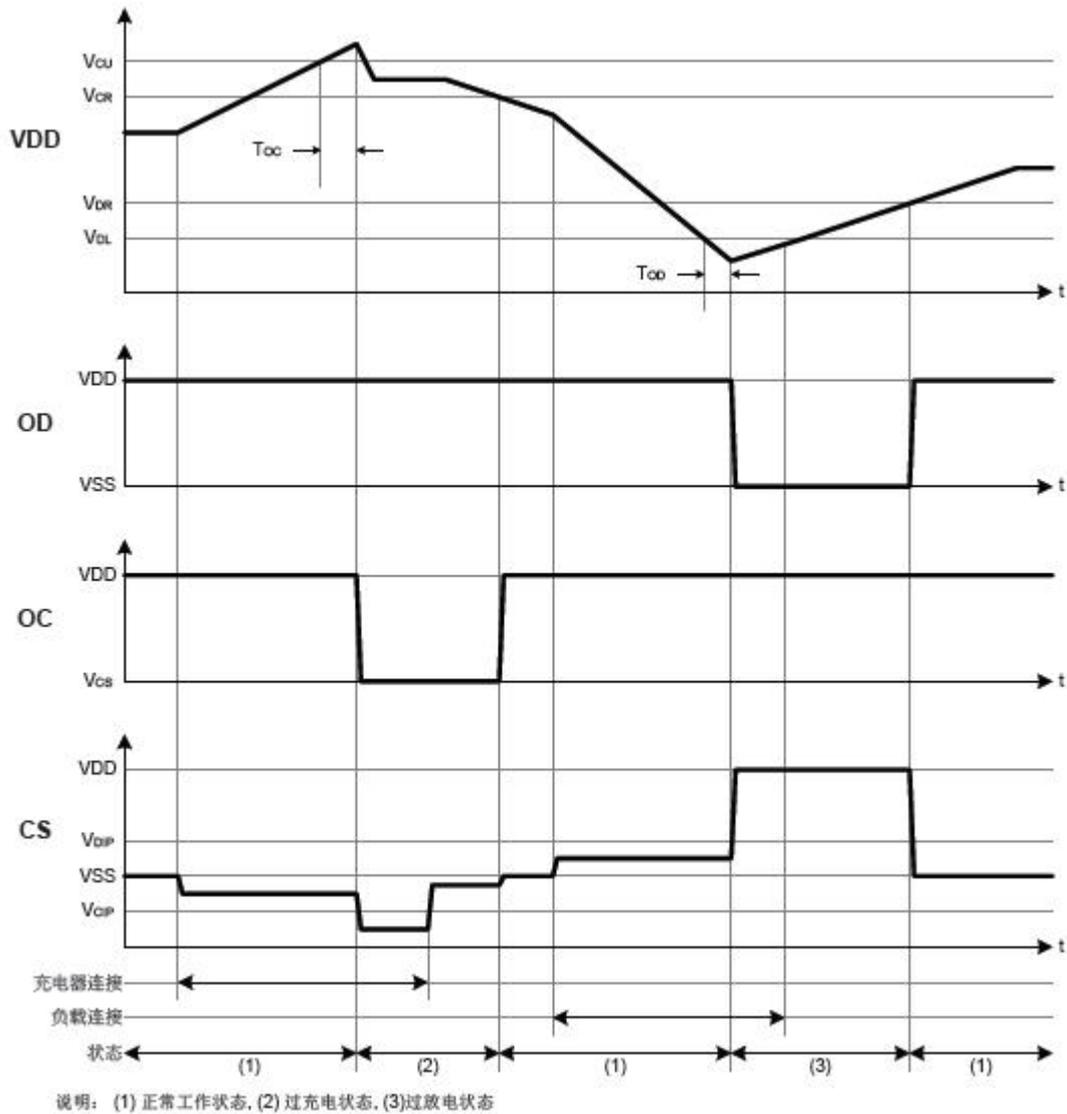
## (2) 过充电检测，过放电检测



说明：

- (a) 过充释放条件： $V_{CIP} < V_{CS} < V_{DIP} \ \& \ V_{DD} < V_{CR}$ 。
- (b) 过放释放条件： $V_{CS} > V_{CIP} \ \& \ V_{DD} > V_{DR}$ 。

(3)过充电检测，过放电检测（有过放自恢复功能）

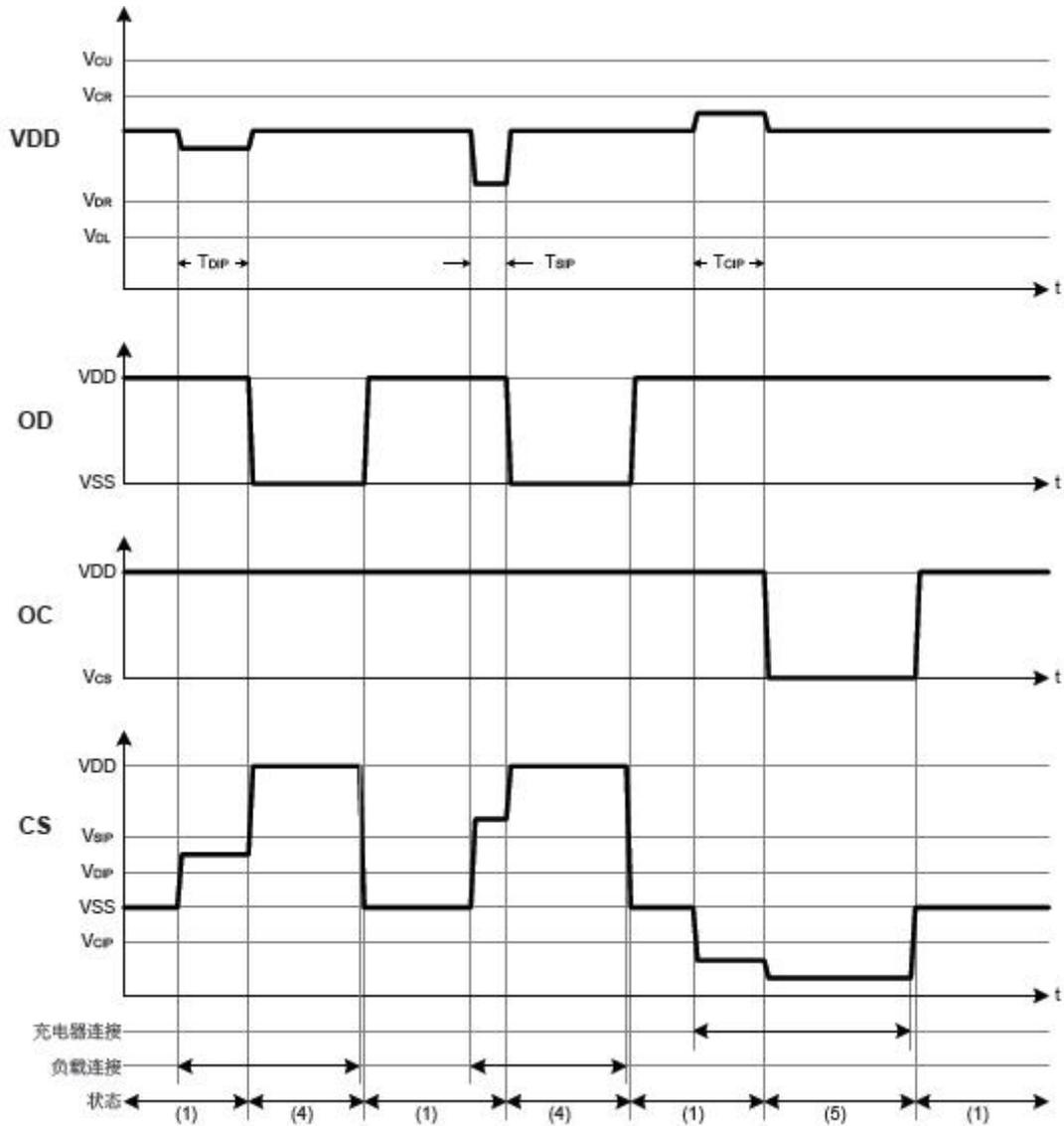


说明：

(a) 过充释放条件： $V_{CIP} < V_{CS} < V_{DIP}$  &  $V_{DD} < V_{CR}$ 。

(b) 过放释放条件： $V_{DD} > V_{DR}$ 。

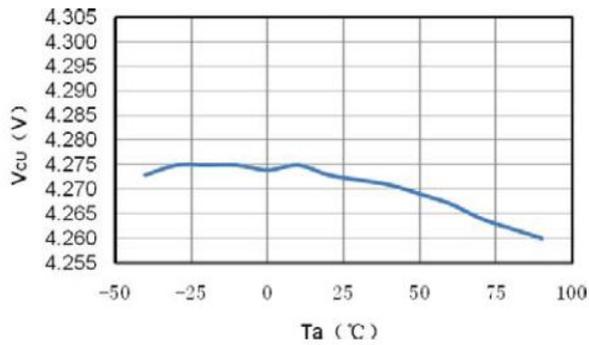
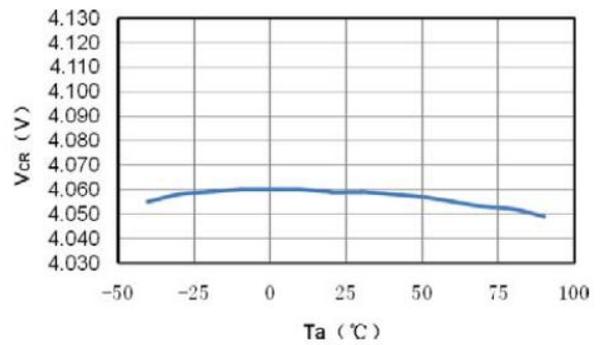
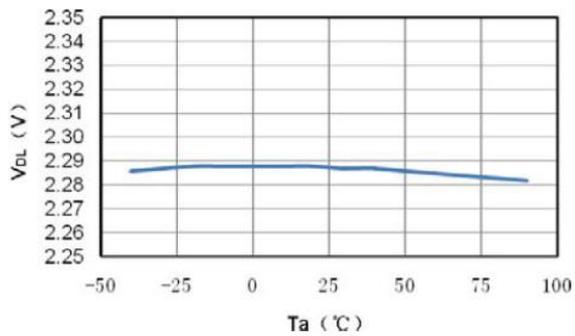
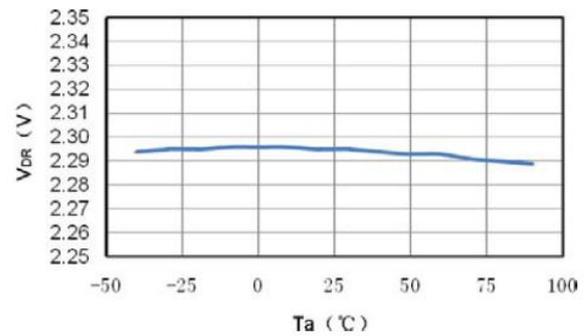
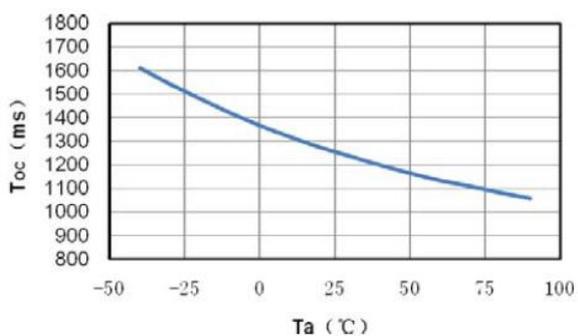
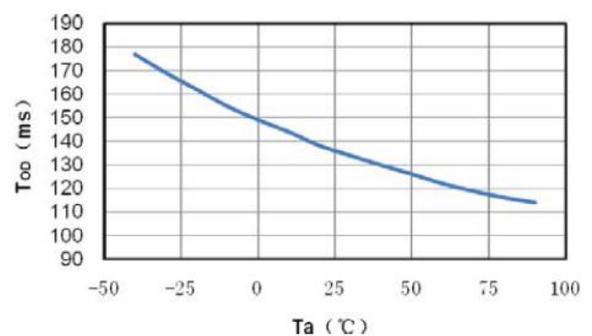
(4)放电过流检测，负载短路检测，充电过流检测



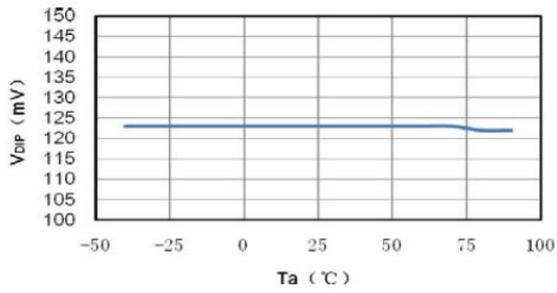
说明：(1) 正常工作状态, (4) 放电过流状态(放电过流及负载短路), (5) 充电过流状态

## 特性（典型数据）

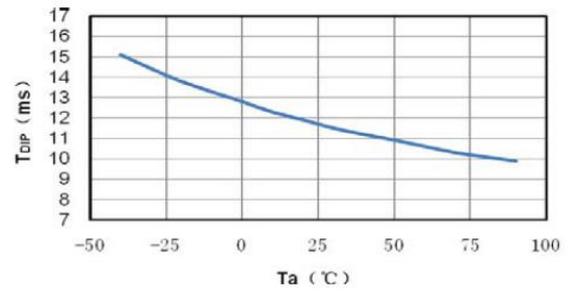
1. 过充电检测电压/过充电释放电压，过放电检测电压/过放电释放电压，放电过流检测电压/负载短路检测电压，充电过流检测电压以及各延迟时间。

(1)  $V_{CU}$  vs.  $T_a$ (2)  $V_{CR}$  vs.  $T_a$ (3)  $V_{DL}$  vs.  $T_a$ (4)  $V_{DR}$  vs.  $T_a$ (5)  $T_{OC}$  vs.  $T_a$ (6)  $T_{OD}$  vs.  $T_a$ 

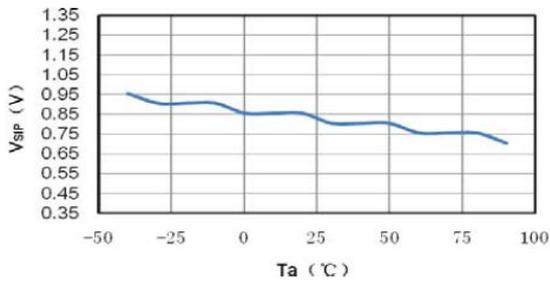
(7)  $V_{DIP}$  vs.  $T_a$



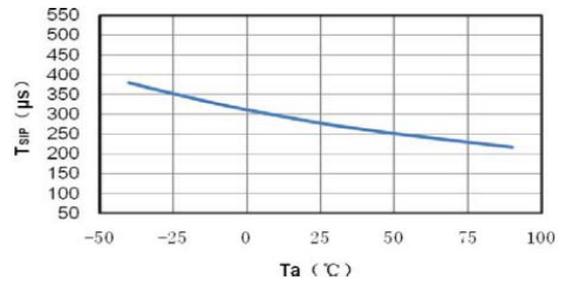
(8)  $T_{DIP}$  vs.  $T_a$



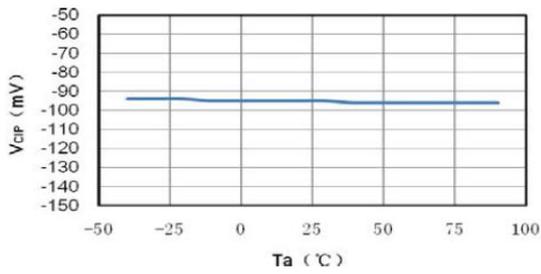
(9)  $V_{SIP}$  vs.  $T_a$



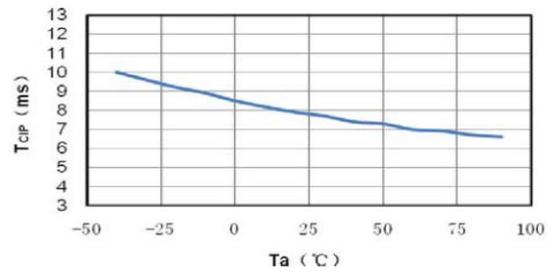
(10)  $T_{SIP}$  vs.  $T_a$



(11)  $V_{CIP}$  vs.  $T_a$

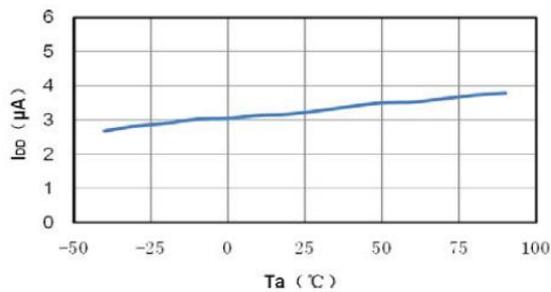


(12)  $T_{CIP}$  vs.  $T_a$

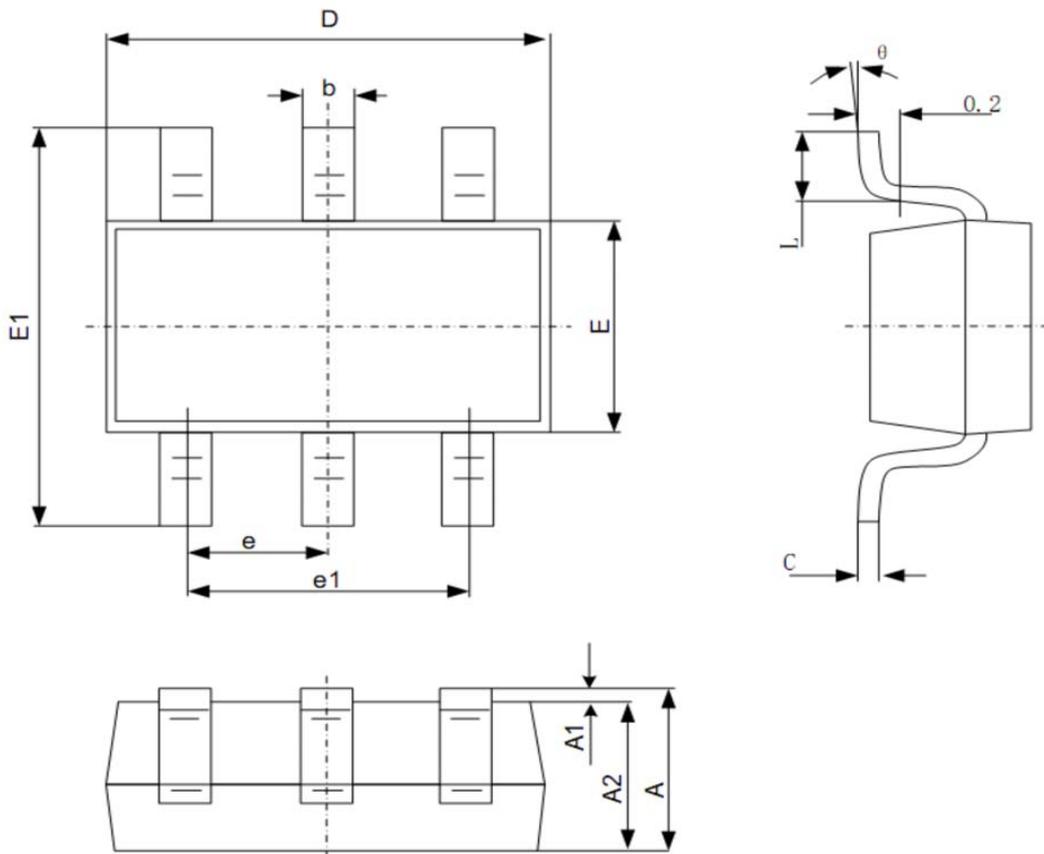


## 2. 耗电流

(13)  $I_{DD}$  vs.  $T_a$



## 封装信息 (SOT23-6L)



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.900	1.200	0.035	0.047
A1	0.000	0.150	0.000	0.006
A2	0.900	1.100	0.035	0.043
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.800	3.020	0.110	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.600	3.000	0.102	0.118
e	0.950 (BSC)		0.037 (BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°